



ドイツ・フランス公報全文英語データの追加 ～画面例～

[de]Flusseinstellvorrichtung
[DE] Flow Adjusting Device

ドイツ文献

出願人 : (DISCO CORP(DISCO CORPORATION))

発明者 : (SUNAGAWA TAKESHI(SUNAGAWA, TAKESHI))

出願番号 : (DE201410212453) [2014-06-27]

文献番号 : DE102014212453A1 (DE102014212453A1) [2014-12-31] [公報PDF](#) [フロントPDF](#)

I P C : (F16L25/14)

E C L A :

C P C : F16K7/04; Y10T137/87877

優先権主張番号 : JP20130136273

英語/中国語	日本語
<invention-title>	【発明の名称】
[de]Flusseinstellvorrichtung	
[DE]Flow Adjusting Device	
<abstract>	【要約】
[de]Eine Flusseinstellvorrichtung zum Einstellen der Flussrate eines in mehreren Röhren fließenden Fluids wird bereitgestellt. Die Flusseinstellvorrichtung beinhaltet eine Röhrenkopplungsverbindung mit einem Verbindungskörper und mehreren Eingriffsvorsprüngen. Der Verbindungskörper weist mehrere Verbindungsöffnungen zum jeweiligen Verbinden der Röhren auf. Die Eingriffsvorsprünge sind an den inneren Umfangsoberflächen der Verbindungsöffnungen des Verbindungskörpers angebracht und wirken so, dass sie jeweils mit den äußeren Umfangsoberflächen der Röhren in Eingriff stehen. Die Flusseinstellvorrichtung beinhaltet ferner mehrere innere Hülsen, die äußere Durchmesser aufweisen, die jeweils den inneren Durchmessern der Röhren entsprechen, und dafür ausgelegt sind, jeweils in die vorderen Endabschnitte der Röhren eingepasst zu werden. Die inneren Hülsen wirken so, dass sie die Eingriffskräfte der Eingriffsvorsprünge, die auf die äußeren Umfangsoberflächen der in die Verbindungsöffnungen der	



ドイツ・フランス公報全文英語データの追加 ～画面例～

<description>	【詳細な説明】
BACKGROUND OF THE INVENTION	
Field of the invention	
[0001] a flow adjusting device for adjusting the flow rate of a fluid The present invention relates to, the flows in several tubes.	
Description of the state of the type	
[0002] In be more than roads designated a semiconductor device-Fabrication method, at the front of a substantially disk-like semiconductor wafer formed intersecting dividing lines, a plurality of regions to be formed thereby to divide , in each of which a plurality of components, such as ICs and LSIs,. The back surface of the semiconductor wafer is ground with a grinding device, so as to reduce the thickness of the semiconductor wafer to a predetermined thickness. Afterwards the semiconductor wafer along the streets Terminating with a cutting device or a laser processing device, to obtain thereby the individual components which are separated from one another.	
[0003] The grinding device for grinding the backside of a wafer, such as a semiconductor wafer, includes a chuck table for holding said wafer under suction, an abrasive with a grinding wheel for grinding the wafer held on the chuck table, wherein the grinding wheel is mounted on a rotating shaft, and a cleaning means for cleaning said wafer with the abrasive ground (see e.g. the exposed JP2005-153090).	
[0004] a chuck table Cutting device for separating a wafer into the individual components The includes for holding the wafer under suction, a cutting means having a cutting blade for cutting the wafer held on the chuck table, wherein the cutting blade is mounted on a rotating shaft, and a cleaning means for cleaning said wafer with the cutting means cut (see e.g. the exposed JP2001-7058).	

独英機械翻訳文